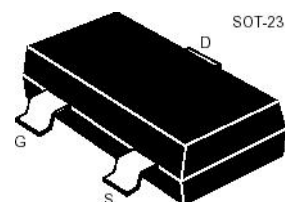


SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

■ **MAXIMUM RATINGS** 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	100	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 20	V
Drain Current-continuous 漏極電流-連續	I_{DR}	150	mA
Drain Current-pulsed 漏極電流-脉冲	I_{DRM}	600	mA

■ **THERMAL CHARACTERISTICS** 熱特性

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^{\circ}C$ 環境溫度為 $25^{\circ}C$	P_D	250	mW
Derate above $25^{\circ}C$ 超過 $25^{\circ}C$ 遞減		1.8	mW/ $^{\circ}C$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	500	$^{\circ}C/W$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	150 $^{\circ}C$, -55to+150 $^{\circ}C$	

■ **DEVICE MARKING** 打標

BSS123=SA

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

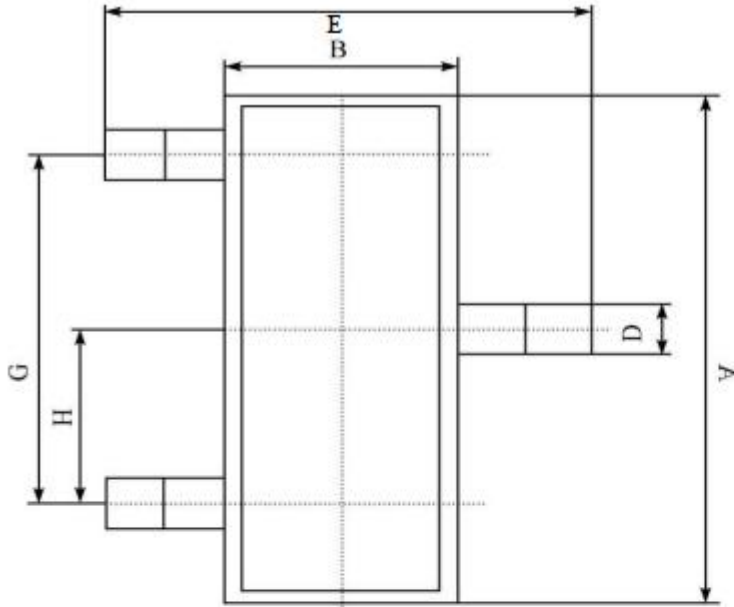
($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓($I_D=10\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$)	BV_{DSS}	100	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓($I_D=1\text{mA}, V_{GS}=V_{DS}$)	$V_{GS(th)}$	1.0	—	2.8	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降($I_{SD}=200\text{mA}, V_{GS}=0\text{V}$)	V_{SD}	—	—	1.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=60\text{V}$)	I_{DSS}	—	—	100	nA
Gate Body Leakage 柵極漏電流($V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$)	I_{GSS}	—	—	± 100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻($I_D=120\text{mA}, V_{GS}=10\text{V}$)	$R_{DS(ON)}$	—	3.5	6	Ω
Input Capacitance 輸入電容 ($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{ISS}	—	—	40	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{OSS}	—	—	25	pF
Turn-ON Time 開啓時間 ($V_{DS}=50\text{V}, I_D=200\text{mA}, R_{GEN}=25\Omega$)	$t_{(on)}$	—	—	10	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ($V_{DS}=50\text{V}, I_D=200\text{mA}, R_{GEN}=25\Omega$)	$t_{(off)}$	—	—	20	ns

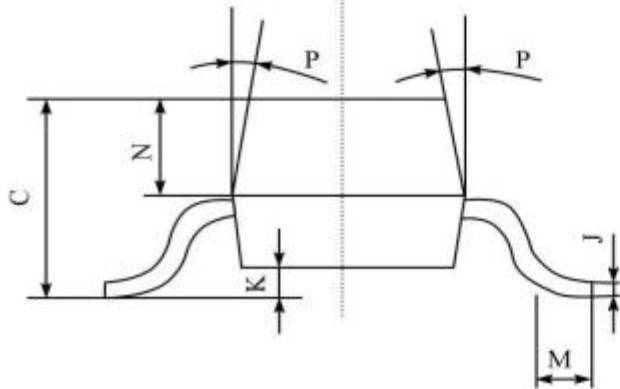
1. FR-5=1.0×0.75×0.062in.
2. Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
3. Pulse Width≤300 μ s; Duty Cycle≤2.0%.

■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Yongyutai Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[IRFD120](#) [JANTX2N5237](#) [2SK2267\(Q\)](#) [BUK455-60A/B](#) [TK100A10N1,S4X\(S](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [NDP4060](#) [SI4482DY](#)
[IRS2092STRPBF-EL](#) [IPS70R2K0CEAKMA1](#) [SQM120N06-3M5L-GE3](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [TK31J60W,S1VQ\(O](#) [TK16J60W,S1VQ\(O](#)
[2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [P85W28HP2F-7071](#) [NTE2384](#) [DMC2700UDMQ-7](#) [DMN2080UCB4-7](#)
[DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#)
[STF5N65M6](#) [IRF40H233XTMA1](#) [STU5N65M6](#) [DMN6022SSD-13](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IPS60R360PFD7SAKMA1](#)
[DMN2990UFB-7B](#) [SSM3K35CT,L3F](#) [IPLK60R1K0PFD7ATMA1](#) [2N7002W-G](#) [MCAC30N06Y-TP](#) [IPWS65R035CFD7AXKSA1](#)
[MCQ7328-TP](#) [SSM3J143TU,LXHF](#) [DMN12M3UCA6-7](#) [PJMF280N65E1_T0_00201](#) [PJMF380N65E1_T0_00201](#)
[PJMF280N60E1_T0_00201](#) [PJMF600N65E1_T0_00201](#) [PJMF900N65E1_T0_00201](#)